(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR ELEMENT

(11) 61-59824 (A)

(43) 27.3.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-181916

(22) 31.8.1984

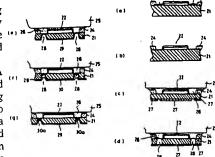
(71) FUJITSU LTD (72) MASAHIKO SHIMAZAKI

(51) Int. Cl. H01L21/28,H01L29/80

PURPOSE: To prevent damage on the handling of an FET element by forming a pattern for a resist required for isolating an electrode with four sides by whole-surface exposing and developing a resist film applied on the whole surface of the back of a GaAs substrate when the electrode is shaped in a latticed

groove formed to the back of the substrate.

CONSTITUTION: An FET element 22 is shaped onto a GaAs substrate 21. A scribing metal 23 is patterned onto the substrate 21 to a latticed form, and the scribing metal 23 is removed through etching. A glass plate 25 for protecting the surface is stuck by using wax 26 prior to the formation of a groove to the back of the substrate 21, the thickness of the substrate 21 is shaven, a second resist film is applied and shaped onto the back of the substrate, and the resist film is exposed by employing a glass mask and developed to form a resist film 27. The back of the substrate 21 is photoetched while using the resist film 27 as a mask to shape grooves 28. The resist film 27 is removed, and a conductive metallic film 29 is formed onto the whole surface of the back of the substrate 21. The metallic film 29 is shaped by evaporating Ti first and Au. The metallic film 29 is evaporated, and a resist film 30 is formed.



(54) ELECTRON BEAM EXPOSURE EQUIPMENT

(11) 61-59825 (A)

(43) 27.3.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-181969 (22) 31.8.1984

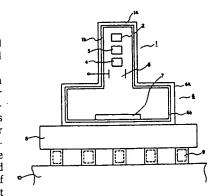
(71) FUJITSU LTD (72) YOSHINOBU ONO

(51) Int. Cl⁴. H01L21/30,H01J37/16

PURPOSE: To obtain a light-weight equipment by executing a magnetic shield consisting of a ferromagnetic material onto the inner surface of an outer wall

constituted by a light metal or a light metal alloy.

CONSTITUTION: A lens tube 1 is constituted by a tubular material in which a permalloy plate 1b in approximately 1mm thickness is lined onto the inner surface of an aluminum plate 1 in approximately 10mm thickness, and an electron gun 2, an electronic oven system 3, an X-axis deflection device 4, a Y-axis deflection device 5, etc. are mounted into the lens tube. An exposure chamber 6 is constituted by a tabular material in which a permalloy plate 6b in approximately 1mm thickness is lined onto the inner surface of an aluminum plate 6a in approximately 30~40mm thickness. A semiconductor wafer to be exposed is placed onto a stage 7, and can be moved and adjusted in the directions of an X axis and a Y axis. The outer wall of an electron-beam exposure equipment constituted in this manner is manufactured by a light-weight material, thus reducing the weight of equipment to approximately 50% of a piece of equipment consisting of an iron group material.



(54) ELECTRON BEAM EXPOSURE EQUIPMENT

(11) 61-59826 (A)

(43) 27.3.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-182063

(22) 31.8.1984

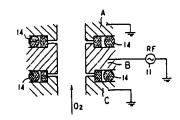
(71) FUJITSU LTD (72) HIROSHI YASUDA(1)

(51) Int. Cl⁴. H01L21/30,H01J37/09,H01J37/305

PURPOSE: To clean a column without overhauling by a method wherein a vacuum built-in part for the column and an electrode are insulated from a ground, high-frequency voltage is applied, O2 gas is flowed to insulated sections and

the fouling of a carbon compound is ashed.

CONSTITUTION: A pipe wall is divided into three sections of A, B and C, and sealed by O rings 14, A and C are connected to ground, and B is insulated. High-frequency voltage is applied to B from a power supply 11 on cleaning. Electric fields are generated between A and B and between B and C at that time, and O2 gas is changed into plasma in the electric fields. Since the same potential is obtained in axial symmetry on transverse on the pipe wall, plasma is not generated in the inside only by merely applying high-frequency voltage, thus insulating each section through proper division, then generating electric fields in the inside as mentioned above. It is preferable that a section, to which high-frequency voltage is applied, in the pipe wall is normally grounded previously and connected to the power supply 11 at high frequency only on cleaning.



-121 122

[®] 公開特許公報(A) 昭61-59825

⑤ Int. Cl.⁴
H 01 L 21/30
H 01 J 37/16

識別記号

庁内整理番号 G-6603-5F ❸公開 昭和61年(1986)3月27日

G-6603-5F 7129-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

会発明の名称

電子ビーム露光装置

②特 顋 昭59-181969

20出 願 昭59(1984)8月31日

79発明者 小野

義 暢

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

卯出 顋 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 并理士 松岡 宏四郎

00 £0 31

1、范明の名称

電子ピーム錯光裝置

2. 特許請求の範囲

3. 免明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、電子ビーム器光装置の改良に関する。特に、自重を小さくし、電子ビーム器光装置の必須附属装置である防頓台を小型径量になすで Qに関する。

(従来の技術)

電子ビームを照射してフォトレジストを選光する電子ビーム選光装置は、(イ)電子レンズ等を使用すれば極めて細い電子ビームを得ることができること、(ロ)電子ビームの走査額費は極めて正確・新聞になしうる等の理由により、数量パ

ターンを正確に選光することを可能にする。

(強明が解決しようとする問題点)

しかし、一方、電子ピームを正確に翻貫することが必須であるから、外部段外の影響を排除することが必須である。そのため、電子ピーム器光光の外壁は強強性材料一般には無または低系合金をもって構成されて、磁気シールドのためである。その結果、選先に変の自重は数百によるには、同様に数重には、での自重をもって構成される銀筒の自重を加えると1トン以上に及ぶ場合もある。

一方、所望の牧師知味に、電子ピームを正確に開射するためには、電子ピーム端光交及を無緩動に保持することが望ましいので、電子ピーム端光設は造帝防殺台上に乗せて使用される。防殺台は本来大きな自重を有するものであり、1トン以上である場合が多い。その結果、防殺台を会めた場合、電子ピーム端光装置の自重は2トン以上にも速するという欠点がある。

(周辺点を解決するための手段)

水発明は、この欠点を紹前することにあり、その手段は、外壁が低金比または経金は白金をもって構成され彼外壁の内面に強磁性材よりなる磁気シールドの施されてなる電子ピーム器光装盤よりなる。

(作用)

本発明に係る電子ビーム端光装盤は、 その端光 玄の構造材がアルミニウムまたはアルミニウム系 合金をもって構成されており、 その内面にパーマ ロイ等透磁率が振めて大 きな強磁性材 の内型

1 は独物であり厚10mm程度のアルミニウム版 1 aの内面に厚さ1 mm程度のパーマロイ版 1 b が内変りされた版状材をもって構成される。 2 は X も方向の内面になかり、 5 は Y も方向の設立であり、 5 は Y も方向の設立であり、 5 は Y も方向の設立であり、 5 は Y も方向の設立であり、 6 は 光光 立の内面に厚さ 1 mm程度のパーマロイ版 6 b が内張りされた版状材をもって構造のパースにある。 7 はステージであり、 異光される半導体ウェーバが乗せられ、 X も、 Y も方向に多効・顕然が可能とされている。

以上の如く構成された他子ピーム環光設設は、 軽量材をもって外壁が製造されているので、自正 は鉄系材の場合に比し約50%程度に減少される (比重比は2.7/7.86=0.34であるが、パーマロイ の内張りが追加され、重量が増加される製造もあるからである)。

8は断線台であり、材料は関わない。電子ビー ム岩光炎駅の重量が50%程度に転少するので、こ の切場台8の付重も大幅に転少される。 リがなされて磁気シールドとされているので、従来の場合と所様、外部磁界の影響は十分排除されるが、その自承は大幅に減少される。鉄系材を構造材に使用する場合と同一の機械的強度を保有させるために軽量材よりなる外態の厚さは、鉄系材の場合に比べて、いくらか厚くする必要があるが、パーマロイでよりなる磁気シールドの厚さは1mm程度で十分である。透磁率が振めて大きいからである。

もし、 端光室に加えて緑質の外壁も軽量化すれば、 緑筒の自重が減少するに加えて端光室の自重も減少する効果がある。

電子ビーム端光装置の自重が減少すると、これを支える的複合の自重も減少することができるから、 切扱合も経量化することができる。

(変施例)

以下、図面を非照しつい、本意明の実施研に係る電子ビーム端光袋器についてさらに詳細に説明 オス。

第 1 図 4 億

9 は空気ばねであり、建設床 10を伝播して来る 振動を助扱台 8 に伝達させない目的を有する。 (条項の効果)

以上説明せるとおり、本発明によれば、岩光窓の外壁が(所望により独特の外壁も)軽金はまたは軽金は合金をもって構成されるの内面にパーマロイ等透磁率が振めて大きな強磁性材の内質りがなされて磁気シールドとされているので、自血の軽い電子ビーム岩光炎数が提供され、これに附はする防振台の自血も減少することができる。

4. 超面の簡単な説明

図は、本発明の実施例に係る電子ビーム第光数 数の概念的構成図である。

1・・・ 位は、 1 a・・・ フルミニウム版、
1 b・・・ 位子レンズ系、 4・・・ X 額 方 向 優光数額、 5・・・ Y 額 方 向 優 向 数 段、
6・・・ 端光変、 6 a・・・ アルミニウム版、 7・・・ ステージ、 8・・・ 助収台、 9・・・ 2 気は

ね、・10・・・足以来。 作用人 弁理士 約8

